かつ、ナノメートルで表した光源の波長に〇・二五を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値が四五以下のもの（へ（一）２に該当するものを除く。）

ワ　極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に調合したレジストを塗布し、成膜し、加熱し、又は現像するために設計した装置　［新設］

カ　ドライエッチング用に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの　［新設］

（一）　等方性ドライエッチング用に設計し、又は改造した装置であって、シリコンゲルマニウムのシリコンに対するエッチング選択性の比率が一〇〇倍以上であるもの

（二）　異方性ドライエッチング用に設計し、又は改造した装置であって、次の全てに該当するもの

１　高周波のパルス出力の電源を一以上有するもの

２　切替時間が三〇〇ミリ秒未満の高速ガス切替弁を一以上有するもの

３　静電チャック（個別に温度を制御することができる領域を二〇以上有するものに限る。）を有するもの

ヨ　ウェットエッチング用に設計した装置であって、シリコンゲルマニウムのシリコンに対するエッチング選択性の比率が一〇〇倍以上であるもの　［新設］

タ　異方性エッチング用に設計した装置であって、誘電体の材料に対して、エッチングの幅に対する深さの比率が三〇倍を超え、かつ、当該幅の寸法が一〇〇ナノメートル未満の形状を形成することができるもののうち、次の全てに該当するもの（カ又はヨに該当するものを除く。）　［新設］

（一）　高周波のパルス出力の電源を一以上有するもの

（二）　切替時間が三〇〇ミリ秒未満の高速ガス切替弁を一以上有するもの

レ　半導体製造装置のうち、成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの　［新設］

（一）　電気メッキによりコバルトを成膜するように設計したもの

（二）　コバルト又はタングステンをボトムアップ成膜によって充塡する工程において充塡する金属の空隙又は継ぎ目の最大寸法が三ナノメートル以下となるように設計した化学的気相成長装置

（三）　単一のチャンバー内での複数の工程によって金属のコンタクト層を成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの

（二）に該当するものを除く。

１　ウエハーの基板温度を一〇〇度超五〇〇度未満に維持しながら、有機金属化合物を用いてタングステンの層を成膜するもの

２　水素（水素と窒素又はアンモニアとの混合物を含む。）を用いたプラズマによる工程を有するもの

（四）　半導体製造装置であって、複数のチャンバー又はステーション内での複数の工程によって成膜するものであり、かつ、複数の工程間において〇・〇一パスカル以下の真空状態又は不活性の環境を維持することができるように設計したもの（以下「特定半導体製造装置」という。）のうち、次に掲げる全ての工程により金属のコンタクト層を成膜するように設計したもの（（二）に該当するものを除く。）

１　ウエハーの基板温度を一〇〇度超五〇〇度未満に維持しながら、水素（水素と窒素又はアンモニアとの混合物を含む。）を用いたプラズマにより表面処理を行う工程